



【筑波 GaNの結晶成長技術開発研究者】ご経験者を募集しています。

国内最大手の石油化学メーカー

Job Information

Recruiter

GLOBAL RESEARCH INC.

Hiring Company

国内最大手の石油化学メーカー

Job ID

1603604

Division

茨城事業所

Industry

Chemical, Raw Materials

Company Type

Large Company (more than 300 employees)

Job Type

Permanent Full-time

Location

Ibaraki Prefecture, U-shi Ku-shi

Salary

7.5 million yen ~ 14 million yen

Refreshed

August 13th, 2026 16:17

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 6 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Basic

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

次世代パワー半導体である窒化ガリウム（GaN）の気相法による結晶成長技術開発をご担当いただきます。
中長期的な視点に立ち、特に次世代製品（大口径基板・低欠陥密度基板・低抵抗品基板等）の新製品開発に重きを置いた、挑戦的かつ自由度の高い開発業務をお任せします。

< 担当業務項目 >

GaNの結晶成長技術の開発業務を中心に、ご経験やご希望などを踏まえて以下に例示する担当業務をご提案いたします。

本ポジションは中長期の技術開発・新製品創出を担う"攻めの研究開発"を行うポジションです。

1) 新製品の結晶成長技術開発：大口径・低欠陥密度・低抵抗品など、次世代基板の結晶成長技術を創り上げる開発業務を行います。

2) 既存製品の歩留り改善や、品質安定化：結晶成長起因の歩留り低下や品質不良に関する不良に対し、原因解析からプロセス改善まで一気通貫で歩留まり向上を図ります。

Required Skills

【必須条件】

- ・化合物半導体の結晶成長技術開発、もしくは結晶成長・薄膜成長に関連する技術開発の経験

【歓迎要件】

- ・物理、化学、化学工学、材料科学、機械工学、電気・電子工学（特に化合物半導体の結晶成長を専攻していた方）
- ・GaN（窒化ガリウム）の結晶成長技術開発、ウエハ加工等の経験（即戦力として特に歓迎）
- ・語学力：英語

Company Description

国内最大手の石油化学メーカー